
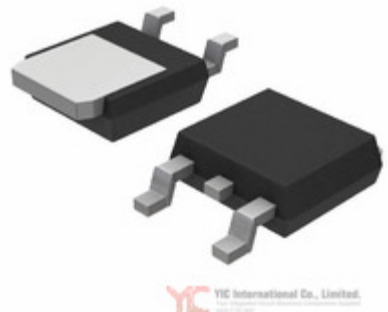
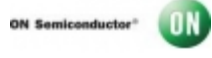

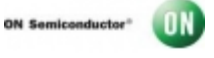

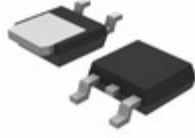
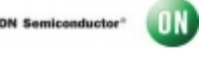

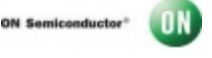
	<h2 style="color: red;">NVD5C648NLT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD5C648NLT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: T6 60V LL DPAK</p> <p>Datenblätter:  NVD5C648NLT4G.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5C648NLT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	T6 60V LL DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.1 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 72W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 18A (Ta), 89A (Tc) 3.1W (Ta), 72W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 89A (Tc)

NVD5C648NLT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5C648NLT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5C648NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD5C648NLT4G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5C632NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 29A 155A DPAK</p>	 <p>NVD5C478NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5C688NLT4G ON Semiconductor T6 60V LL DPAK</p>	 <p>NVD5C486NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>
 <p>NVD5C486NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V DPAK EXPANSION AND</p>	 <p>NVD5C668NLT4G ON Semiconductor T6 60V LL DPAK</p>	 <p>NVD6414ANT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 34A DPAK</p>	 <p>NVD5C684NLT4G ON Semiconductor T6 60V LL DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5C648NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5C648NLT4G Datenblatt	NVD5C648NLT4G-Datenblätter	NVD5C648NLT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5C648NLT4G
NVD5C648NLT4G Electronic	NVD5C648NLT4G-Komponenten	NVD5C648NLT4G-Verteiler	NVD5C648NLT4G-Bild	NVD5C648NLT4G-Teil
NVD5C648NLT4G Preis	NVD5C648NLT4G Hersteller	NVD5C648NLT4G Bild	NVD5C648NLT4G Aktie	NVD5C648NLT4G Inventar
NVD5C648NLT4G Neu	NVD5C648NLT4G Original	NVD5C648NLT4G garantiert	NVD5C648NLT4G RFQ	NVD5C648NLT4G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited